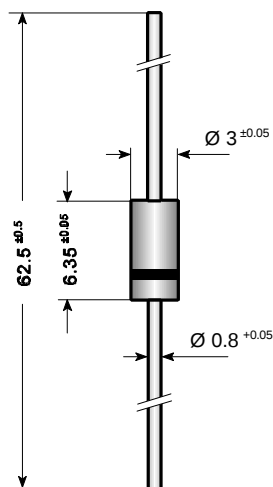


Silicon Rectifiers
Silizium Gleichrichter


Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom	3 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...1000 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	DO-15
Weight approx. – Gewicht ca.	0.4 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	see page 17 siehe Seite 17

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
1N 5400K	50	50
1N 5401K	100	100
1N 5402K	200	200
1N 5403K	300	300
1N 5404K	400	400
1N 5405K	500	500
1N 5406K	600	600
1N 5407K	800	800
1N 5408K	1000	1000

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschialtung mit R-Last	$T_A = 50^\circ\text{C}$	I_{FAV}	3 A ¹⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	30 A ¹⁾
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	50 A ² s

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Peak fwd. surge current, 50 Hz half sine-wave,
superimposed on rated load

$T_A = 25^\circ\text{C}$

I_{FSM}

100 A

Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen,
überlagert bei Nennlast

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur

T_j

– 50...+175°C

Storage temperature – Lagerungstemperatur

T_s

– 50...+175°C

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage – Durchlaßspannung

$T_j = 25^\circ\text{C}$

$I_F = 3\text{ A}$

V_F

< 1.2 V

Leakage current – Sperrstrom

$T_j = 25^\circ\text{C}$

$V_R = V_{\text{RRM}}$

I_R

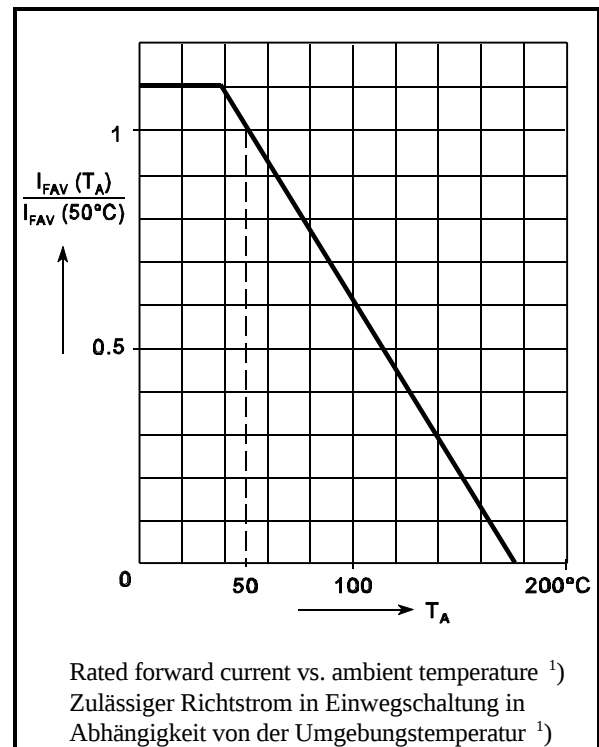
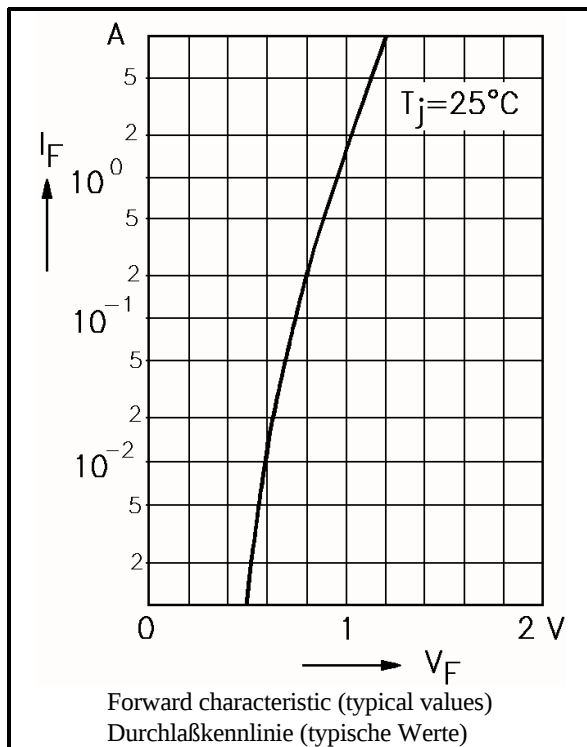
< 10 μA

Thermal resistance junction to ambient air

R_{thA}

< 45 K/W ¹⁾

Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft



¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden